

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в измерительных приборах, в которых используются сенсоры на основе наноструктурных полупроводниковых оксидов.

Устройство для измерения параметров сенсора на основе наноструктурных полупроводниковых оксидов в диапазоне порядка микроватт включает источник регулируемого опорного напряжения, соединенный последовательно с исследуемым сенсором и образцовым сопротивлением, полное падение напряжения на сенсоре и образцовом сопротивлении и, отдельно, падение напряжения на образцовом сопротивлении прикладываются на входы двух аналого-цифровых преобразователей микроконтроллера через два операционных усилителя, выходы микроконтроллера соединены через цифро-аналоговый преобразователь с входом источника регулируемого опорного напряжения и к экрану для отображения полученного результата.

П. формулы: 1

Фиг.: 2